

# АПРОБАЦІЯ ТРЬОХВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ТЕНЗОЧУТЛИВІСТІ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК

І.Ю.Проценко, Н.М.Опанасюк, А.М.Чорноус  
(Сумський державний університет, м.Суми)

На прикладі тонких плівок Cr та Si проведені апробація трьохвимірної моделі тензочутливості Ц.Тельє, А.Тоссе, Ц.Пішара. Одержано, що експериментальні результати з тензочутливості узгоджуються з розрахунковими лише при допущенні про розмірну залежність деформаційного коефіцієнта середньої довжини вільного пробігу електронів.

## ВСТУП

У зв'язку з актуальністю питання про визначення параметрів електропереносу металевих плівок воно постійно знаходиться в полі зору як експериментаторів, так і теоретиків. В останній час було запропоновано декілька теоретичних моделей, які враховують зовнішній та внутрішній розмірні ефекти (РЕ). Зокрема, широке застосування одержали модель ефективною довжини вільного пробігу, лінеаризовані співвідношення моделі Маядаса-Шатикеса, модель ізотропного розсіювання носіїв електричного струму для термічного коефіцієнту опору (ТКО) [1-3] та коефіцієнта тензочутливості (КТ) [4,2]. Загальним недоліком цих моделей є те, що вони можуть бути застосовані або при умові  $L \geq d$  ( $L$ -середній розмір кристалітів,  $d$ -товщина) [1,2], або при довільному співвідношенні між  $L$  та  $d$ , але в припущенні ізотропності кристалітів. Як подальший розвиток теорії РЕ є трьохвимірна модель для ТКО [5] та КТ [3], в якій допускається, що кристаліти мають довільну форму і  $L_x$ ,  $L_y$  та  $L_z$  в загальному випадку не співпадають.

Метою даної роботи є апробація трьохвимірної моделі РЕ для КТ. Вибір об'єктів дослідження - плівок хрому та міді - визначався цією задачею, оскільки в плівках Cr  $L$  менше, а в Si більше товщини зразків, що дозволяє провести апробацію для цих двох випадків.

## ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Для врахування як зовнішнього, так і внутрішнього РЕ авторами [3] вводяться два параметра розсіювання електронів на межі кристалітів ( $\nu$ ) або на поверхні плівки ( $\mu$ ):

$$\nu = L\lambda_0^{-1}(\ln \frac{1}{r})^{-1}, \mu = d\lambda_0^{-1}(\ln \frac{1}{p})^{-1}, \quad (1)$$

де  $\lambda_0$  - середня довжина вільного пробігу (СДВГ) електронів в об'ємі зразка;  $r$  - коефіцієнт проходження межі кристалітів (МК), який пов'язаний з коефіцієнтом відбивання  $R$  від МК таким співвідношенням [3]:  $R(1-R)^{-1} \cong \ln(r^{-1})$ , де  $p$  - коефіцієнт дзеркальності поверхні плівки.

ТКО металевих плівок. В найбільш загальному вигляді співвідношення, яке пов'язує ТКО з параметрами  $\nu$ ,  $\mu$  та  $z = (\nu + c^2)(1-c)^{-1}$ , де  $c = \frac{4}{\pi}$ , було одержано в [5]:

$$\frac{\beta_z}{\beta_0} = \frac{\nu}{1-c} \frac{\alpha^{-1} - 2 + 2\alpha \ln(1+\alpha^2)}{\alpha - \frac{1}{2} + (1-\alpha^2)\ln(1+\alpha^2)} = \frac{\nu}{1-c} \frac{V(\alpha)}{U(\alpha)}, \quad (2)$$

$\beta_z$  - та  $\beta_0$  - ТКО нескінченно товстої ( $d \rightarrow \infty$ ) полікристалічної плівки та масивного зразка, відповідно.

В роботі [6] співвідношення (2) було конкретизовано для випадку полікристалічної (індекс  $p$ ) або такої, яка задовольняє умові монокристалічності (індекс  $m$ ), плівок:

$$\frac{\beta_p}{\beta_0} = \frac{a_p V(a_p)}{1 + \frac{c^2}{v} U(a_p)}, \quad \frac{\beta_m}{\beta_0} = \frac{a_m V(a_m)}{1 + \frac{c^2}{v} U(a_m)},$$

$$\text{де } a_p = (1 + \frac{c^2}{v}) b_p^{-1}, \quad a_m = (1 + \frac{c^2}{v}) b_m^{-1},$$

$$b_p = \frac{1}{\mu} + \frac{1-c}{\mu}, \quad b_m = \frac{1}{\mu} - \frac{c}{v}.$$

В цій же роботі було одержане лінеаризоване за параметрами  $v$  і  $\mu$  співвідношення для ТКО полікристалічних плівок при умові  $0,1 < v < 4$  та  $\mu > 0,1$ . Аналогічне спрощення було здійснено в [7] при умові монокристалічності плівкового зразка, тобто при  $\mu \ll 1 \ll v$  та  $p < 1, r \equiv 1$ :

$$\left(\beta_m \ln \frac{\lambda_0}{d}\right)^{-1} \approx \beta_0^{-1} \left(1 + \frac{c^2}{v}\right) \left(1 + \left(\ln \frac{\lambda_0}{d}\right)^{-1} \ln \frac{\ln(1/p)}{1 + \frac{c^2}{v}}\right). \quad (3)$$

В тому випадку, коли плівки полікристалічні і виконується умова  $\mu < 1$  та  $v > 1$ , можна користуватися аналогічним лінеаризованим співвідношенням [8]:

$$\left(\beta_p \ln \frac{\lambda_0}{d}\right)^{-1} \approx 1,43 \beta_0^{-1} \left(1 + \frac{c^2}{v}\right) \left(1 + \left(\ln \frac{\lambda_0}{d}\right)^{-1} \ln \frac{\ln(1/p)}{1 + \frac{c^2}{v}}\right). \quad (4)$$

**КТ металевих плівок.** Трьохвимірний модель тензочутливості може бути застосована при умові  $v > 0,4$  і для коефіцієнта поздовжньої тензочутливості ( $\gamma_1$ ) має такий вигляд:

$$\gamma_1 = (\eta_1 + 1) - \eta_1 \frac{F^*(v_x) + G^*(v_y) + G^*(\alpha^*)}{M(v_x, v_y, \alpha^*)} + \frac{\mu_x G^*(v_y) - F^*(v_x) - \mu^* G^*(\alpha^*)}{M(v_x, v_y, \alpha^*)}, \quad (5)$$

де

$$M(v_x, v_y, \alpha^*) = F(v_x)^{-1} + G(v_y)^{-1} + G(\alpha^*)^{-1} - 2 = \frac{\rho}{\rho_0}$$

( $\rho, \rho_0$  - питомий опір плівки та масивного зразка відповідно);  $(\alpha^*)^{-1} = \mu^{-1} + v_x^{-1}$ ; функції  $F(v_x), G(v_y), G^*(\alpha^*)$ , їх похідні

$$f(v_x) = \frac{dF}{dv_x}, g(v_y) = \frac{dG}{dv_y}, g(\alpha^*) = \frac{dG}{d\alpha^*}$$

- відомі функції [3] і нами табульовані (рис.1), а  $F^*(v_x) = v_x f(v_x) F(v_x)^{-2}$ ;

$$G^*(v_y) = v_y g(v_y) G(v_y)^{-2};$$

$$G^*(\alpha^*) = \alpha^* g(\alpha^*) G^*(\alpha^*)^{-2},$$

де  $\mu, \mu^*$  - коефіцієнт Пуассона для матеріалу підкладки та приведений коефіцієнт Пуассона відповідно;  $\eta_1 = -\lambda_0^{-1} \frac{d\lambda_0}{d\varepsilon_1}$  - деформційний коефіцієнт СДВП ( $\varepsilon_1$  - поздовжня деформація).

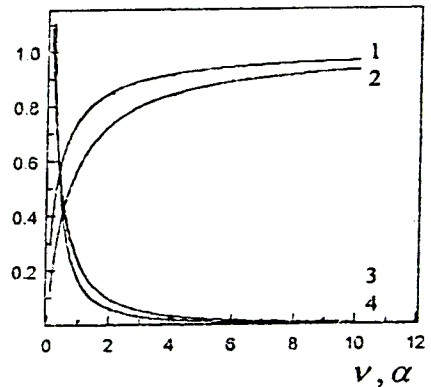


Рис.1. Графічне табулювання функцій розсіювання електронів: 1 -  $G(v)$ ,  $G(\alpha^*)$ ; 2 -  $F(v)$ ; 3 -  $f(v)$ ; 4 -  $g(v)$ ,  $g(\alpha^*)$

## МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Плівки  $\text{Cr}$  та  $\text{Cu}$  конденсувалися і термооброблялися в установці ВУП-ГМ та установці на основі магніто-розрядного насоса (вакуум  $\approx 10^{-4} \dots 10^{-5}$  Па). В якості підкладок використовувалися скляні (вимірювання ТКО) чи текстолітові (вимірювання КТ) пластини та вуглецеві плівки (для проведення електронно-мікроскопічних досліджень). Елементний склад зразків вивчався методом вторинно-іонної мас-спектрометрії (МС 7201 М). В плівках  $\text{Cu}$  були зафіксовані сліди  $\text{CuO}^+$ , хоча електро-

нографічно оксиди Си не спостерігаються. Для вимірювання середнього розміру  $L_x$  та  $L_y$  зразок для електронно-мікроскопічних досліджень орієнтувався таким чином, що напрямком осі  $x$  співпадав з напрямком протікання струму при вимірюванні опору. Розмір  $L_x$  брали рівним товщині плівки.

КТ розраховувався за кутовим коефіцієнтом деформаційної залежності  $\Delta R/R_0$  від  $\epsilon_1$  ( $R_0$  - початковий опір,  $\Delta R$  - його зміна при деформації,  $\epsilon_1 = \frac{\Delta l}{l_0}$ , де  $l_0$  - по-

чаткова довжина плівки), яка одержувалася при повздовжній деформації плівки з підкладкою методом розтягу за допомогою мікрогвинта ( $\epsilon_{max} = 2 \cdot 10^{-2}$ ).

Відпалювання зразків з метою рекристалізації та стабілізації їх електричних властивостей здійснювалося у вакуумній камері за схемою "нагрівання - охолодження" (від 300 до 700 К) зі швидкістю 3 К/хв.

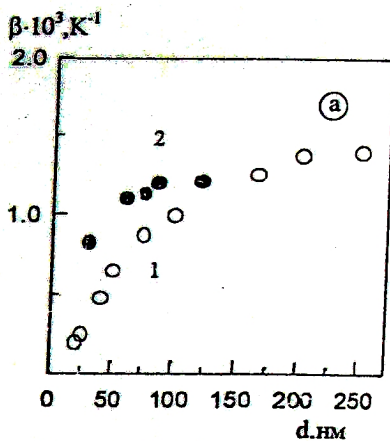
## СБРОВКА ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Експериментальні залежності для ТКО представлені на рис.2.

Оцінка параметрів  $\mu$ ,  $\nu$  та значення коефіцієнтів  $p$  і  $g$  вказують на те, що результати для плівок Си можуть бути оброблені в рамках співвідношення (3), в той час як для Сг - за співвідношенням (4). Використовуючи значення  $\lambda_0$ , одержане в рамках моделі ізотропного розсіювання, було проведено розрахунок параметрів  $p$  і  $g$  (таблиця), які потім використовувалися в співвідношенні (5).

### ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОПЕРЕНОСУ, ЯКІ ОДЕРЖАНІ ІЗ СПІВВІДНОШЕНЬ (3) І (4)

Плівка	$\lambda_0, \text{нм}$ [9]	$g$	$p$
Си	38,7	0,80-0,72	0
Сг	129	0,99	0,01



$[\beta \cdot \ln(\lambda_0/d)]^{-1} \times 10^{-3}, \text{K}$

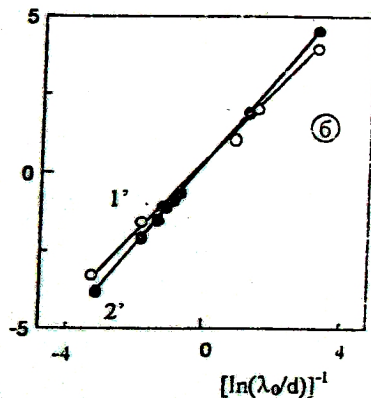


Рис.2. Розмірна залежність ТКО для плівок Сг (1,1') та Си (2,2') в різних координатах ( $T=300 \text{ K}$ )

На рис.3 представлені крім експериментальних даних для КТ  $\gamma_1$ , також і розрахункові. Як видно із цього рисунка, найбільш воюана відповідність має місце, коли величина  $M(v_x, v_y, \alpha^*) = \rho/\rho_0$  розраховується теоретично. В той же час використання експериментальних значень  $\rho/\rho_0$  або  $\rho/\rho_s$  ( $\rho_s$  - питомий опір нескінченно товстої ( $d \rightarrow \infty$ ) плівки, тобто масивного зразка з таким же типом і концентрацією дефектів, як і шлівкового зразка) дає приблизно однакову величину  $\gamma_1$ , яка помітно відрі-



няється від експериментального. Це наводить на думку, що деформаційний коефіцієнт СДВП є сам розмірнозалежним параметром електропереносу (рис.3).

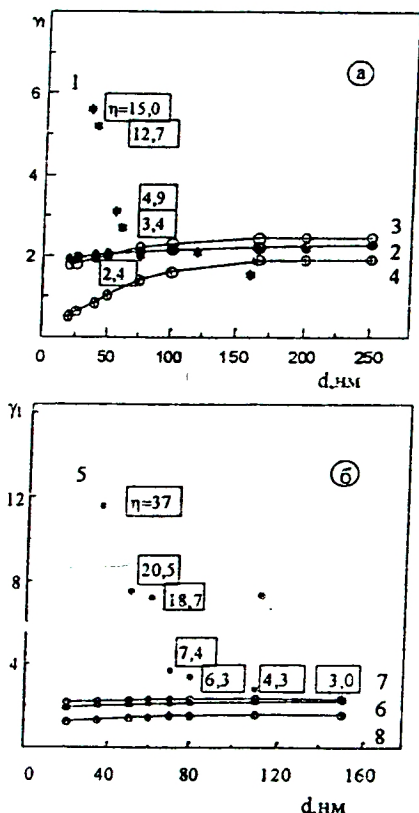


Рис.3 Розмірна залежність КТ для плівок CdTe (а) та Si (б): 1,5 - експериментальні результати; 2-4,6-8 - розрахункові дані при використанні розрахункового (2,6) і експериментального значення  $\rho/\rho_0$  (3,7) або експериментального значення  $\rho'/\rho_0$  (4,8); □ - розрахункові величини деформаційного коефіцієнту СДВП  $\eta$  (числа приведені біля точок) при використанні експериментального значення  $\rho/\rho_0$

Сама ідея про такий розмірний ефект не може викликати великих заперечень, хоча

би з тієї причини, що багато фізичних величин залежать від товщини плівки. З іншого боку необхідно також підкреслити, що в трьохвимірній моделі тензочутливості використовуються величини, які важко проконтролювати експериментально:  $L_x$ ,  $L_y$ ,  $L_z$  і відповідно -  $v_x, v_y$ , та  $\alpha^\circ$ . Нами спостерігалось, що навіть незначні зміни розмірів та форми кристалітів обумовлюють значну зміну  $\rho$  та  $\gamma_1$ . При цьому велику роль відіграють межі розділу кристалітів та їх тип (мало - чи великокутові), концентрація домішкових атомів, які локалізуються на межах, та інше. З цієї точки зору, деформаційний коефіцієнт можна розглядати не як розмірний, а підгочний параметр. Однак нам здається, більш правильно говорити в цьому випадку про розмірний ефект параметра  $\eta$ , від товщини плівки.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Tellier C.R., Tosser A.J. // Thin Solid Films. 1977. Vol. 43. №3. P. 261.
2. Pichard C.R., Tellier C.R. // Rev. Phys. Appl. 1979. Vol. 14. №8. P. 743.
3. Tosser A.J., Tellier C.R., Pichard C.R. // J. Mater. Sci. 1981. Vol. 16. №7. P. 944
4. Tellier C.R., Tosser A.J. // Thin Solid Films. 1979. Vol. 59. №1. P. 163.
5. Pichard C.R., Tellier C.R., Tosser A.J. // Phys. Stat. Sol.(a). 1981. Vol. 65. №1. P. 327.
6. Guendouz L., Tellier C.R., Tosser A.J., Pichard C.R. // J. Mater. Sci. Lett. 1984. Vol. 3. №5. P. 377.
7. Pichard C.R., Komnik Yu. F., Belevsev B.I., Tosser A.J. // J. Mater. Sci. 1983. Vol. 2. №7. P. 360.
8. Проценко И.Е. // Изв. вузов. Физика. 1988. №6. С.42.

Статья поступила:

в редакцию

21.10.97

в редакцию

25.11.97